

型名	社名	用途	構造	チャンネル	最大定格						電氣的特性 (Ta=25°C)													
					V***		VGS*	区分*	I*	区分*	Pd/Pch	I _{GSS} (max)	VGS	I _{PSS}		V _{GS(off)}		V _{DS}	I _D	g _m	V _{DS}	I _D		
					(V)	区分***								(A)	(W)	(max)	(min)						(max)	(min)
2SJ106	東芝	LF A, A-SW	J	P D	50	GDS			-10m	G	150m	1n	30	-1.2m	-14m	-10	0.3	6	-10	-0.1μ	1m	4m	-10	IDSS
2SJ107	東芝	LF A, A-SW	J	P D	25	GDS			-10m	G	200m	1n	25	-2.6m	-20m	-10	0.2	2	-10	-0.1μ	12m	30m	-10	IDSS
2SJ108	東芝	LF LN A	J	P D	25	GDS			-10m	G	200m	1n	25	-2.6m	-20m	-10	0.15	2	-10	-0.1μ	8m	22m	-10	IDSS
2SJ109	東芝	LF LN A	J	P D	30	GDS			-10m	G	200m	1n	30	-2.6m	-20m	-10	0.2	2	-10	-0.1μ	8m	22m	-10	IDSS
2SJ110	東芝	LF A, A-SW	J	P D	25	GDS			-10m	G	400m	1n	25	-5m	-30m	-10	0.3	2	-10	-0.1μ	25m	60m	-10	IDSS
2SJ111	東芝	LF LN A	J	P D	25	GDS			-10m	G	400m	1n	25	-5m	-30m	-10	0.3	2	-10	-0.1μ	30m	40m	-10	IDSS
2SJ112	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-100	DSS	±20	S	-10	D	100	±1μ	±20		-1m	-80	-2	-5	-10	-1m	1.5	2	-10	-5
2SJ113	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-100	DSS	±20	S	-10	D	100	±1μ	±20		-1m	-80	-2	-5	-10	-1m	1.5	2	-10	-5
2SJ114	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-200	DSS	±20	S	-8	D	100	±1μ	±20		-1m	-160	-2	-5	-10	-1m	1	1.8	-10	-4
2SJ115	東芝	LF PA	MOS	P E	-160	DSS	±20	S	-8	D	100	±1n	±20				-0.8	-2.8	-10	100m	1	2	-10	-2
2SJ116	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-400	DSS	±20	S	-8	D	125	±1μ	±20		-1m	-320	-2	-5	-10	-1m	1	1.6	-20	-4
2SJ117	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-400	DSS	±20	S	-2	D	40	±1μ	±20		-1m	-320	-2	-5	-10	-1m	0.4	0.7	-20	-1
2SJ118	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-140	DSS	±20	S	-8	D	100	±1μ	±20		-1m	-120	-2	-5	-10	-1m	1	1.8	-10	-4
2SJ119	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-160	DSS	±20	S	-8	D	100	±1μ	±20		-1m	-140	-2	-5	-10	-1m	1	1.8	-10	-4
2SJ120(L)(S)	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-40	DSS	±20	S	-2	D	10	±1μ	±20		-1m	-35	-1	-4	-10	-1m	0.1	0.25	-10	-1
2SJ122	日立	HS PSW, RF PA	MOS	P E	-60	DSS	±20	S	-10	D	50	±1μ	±20		-1m	-50	-2	-5	-10	-1m	1.5	2.2	-10	-5
2SJ123	東芝	LF PA, HS SW	MOS	P E	-70	DSS	±20	S	-10	D	30	±1n	±20		-1m	-70	-1	-3	-5	-1m	1	1.7	-5	-2
2SJ125	三菱	LF PA, A-SW	J	P D	50	DGO			-10m	G	150m	1n	30	-1m	-12m	-10	0.3	6	-10	-10μ	1.5m	4m	-10	IDSS
2SJ126	東芝	HS SW	MOS	P E	-60	DSX	±20	S	-10	D	40	±100n	±20		-1m	-60	-1.5	-3.5	-10	-1m	1.5	2.5	-10	-5
2SJ127	日立	HS PSW	MOS	P E	-120	DSS	±15	S	-10	D	50	±10μ	±12		-0.25	-100	-2	-4	-10	-1m	3	5	-10	-5
2SJ128, 128Z	NEC	SW	MOS	P E	-100	DSS	±20	S	±2	D	20	±100n	±20		-10μ	-100	-1	-3	-10	-1m	1	1.6	-10	-1
2SJ129	松下	LF A	J	P D	50	GDS			-10m	G	300m	100n	30	-0.5m	-14m	-10	0.2	3	-10	-10μ	3m		-10	IDSS
2SJ130(L)(S)	日立	HS SW	MOS	P E	-300	DSS	±20	S	-1	D	20	±10μ	±16		-0.1m	-240	-2	-4	-10	-1m	0.25	0.4	-20	-0.5
2SJ131	Y-	SW	MOS	P E	-170	DSS	±20	S	-10	D	100	±1μ	±20				-1.9	-4.1	-10	-0.65	1.6	2	-10	-2
2SJ132, 132Z	NEC	SW	MOS	P E	-30	DSS	±20	S	±2	D	20	±100n	±20		-10μ	-30	-1	-3	-10	-1m	1	1.8	-10	-1
2SJ133, 133Z	NEC	SW	MOS	P E	-60	DSS	±20	S	±2	D	20	±100n	±20		-10μ	-60	-1	-3	-10	-1m	1	1.8	-10	-1
2SJ134	NEC	SW	MOS	P E	-100	DSS	±20	S	±6	D	40	±100n	±20		-10μ	-100	-1	-3	-10	-1m	1	4	-10	-3.5
2SJ135	NEC	SW	MOS	P E	-100	DSS	±20	S	±5	D	30	±100n	±20		-10μ	-100	-1	-3	-10	-1m	1	4	-10	-3.5
2SJ136	NEC	SW	MOS	P E	-60	DSS	±20	S	±12	D	40	±100n	±20		-10μ	-60	-1	-3	-10	-1m	2	5	-10	-6.5
2SJ137	NEC	SW	MOS	P E	-60	DSS	±20	S	±10	D	30	±100n	±20		-10μ	-60	-1	-3	-10	-1m	2	5	-10	-6.5

電 気 的 特 性 (Ta=25℃)											コンプリ メンタリ	外形	備 考	型 名			
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	VGS (V)	VDS (V)	NF typ dB	NF max dB	f (Hz)	RG (Ω)	RDS(ON) (max) (Ω)	VGS (V)	ID (A)					その他特性	測定条件	
18	3.6	0	-10					270typ	0	-5m				105A	DSG	2SJ106	
105	32	0	-10					40typ	0	-5m				2SK366	70B	DGS	2SJ107
105	32	0	-10	1	10	10	1k							2SK370	70B	DGS	2SJ108
95	25	0	-10	1.5	11	10	1k				ΔVGS=20mVmax			2SK389	148	Dual FET	2SJ109
185	55	0	-10					20typ	0	-15m				2SK363	82C	DGS	2SJ110
185	55	0	-10	1	2	1k	100							2SK369	82C	DGS	2SJ111
1100	90	0	-10								VDS(ON)=-1.75Vmax	ID=-5A, VGS=-15V		2SK398	28B	GSD, 代替2SJ113	2SJ112
1100	90	0	-10					0.35	-15	-5				2SK399	149	GDS	2SJ113
1000	70	0	-10					0.8	-15	-4				2SK400	149	GDS	2SJ114
800	110	0	-10								VDS(ON)=-7Vmax	ID=-5A, VGS=-10V		2SK405	119	GDS	2SJ115
1400	25	0	-10					2.25	-15	-4				2SK298	28B	GSD	2SJ116
520	15	0	-10					7	-15	-1				2SK310	116B	GDS	2SJ117
1050	80	0	-10					0.5	-15	-4				2SK413	149	GDS	2SJ118
1050	80	0	-10					0.5	-15	-4				2SK414	149	GDS	2SJ119
150	25	0	-10					1.5	-15	-1				2SK416	150	GDS	2SJ120(L)(S)
1200	170	0	-10					0.2	-15	-5				2SK428	116B	GDS	2SJ122
650	250	0	-10								VDS(ON)=-2.8Vmax	ID=-7A, VGS=-15V		2SK442	138	GDS	2SJ123
18	3.3	0	-10					220typ	0	5m					128	DSG1G2	2SJ125
880	280	0	-10					0.4	-10	-5					182	GDS, 代替2SJ147	2SJ126
1450	175	0	-10					0.25	-10	-5					116B	GDS	2SJ127
1000	25	0	-10					1	-10	-1	ton=60ns, toff=150nstyp	ID=-1A, VDD=-50V			276/Z:281	Z:ハイブリッド IC用	2SJ128, 128Z
22	3.6	0	-10								NV=80mVmax	Rg=100kΩ, Flat			213B	DGS	2SJ129
235	16	0	-10					8.5	-10	-0.5					150	GDS	2SJ130(L)(S)
1100	50	0	-10								VDS(ON)=-5.5Vmax	ID=-4A, VGS=-10V		2SK722	207	GDS	2SJ131
730	45	0	-10					0.4	-10	-1	ton=60ns, toff=150nstyp	ID=-1A, VDD=-15V			276/Z:281	Z:ハイブリッド IC用	2SJ132, 132Z
730	45	0	-10					0.8	-10	-1	ton=60ns, toff=150nstyp	ID=-1A, VDD=-30V			276/Z:281	Z:ハイブリッド IC用	2SJ133, 133Z
1600	65	0	-10					0.6	-10	-3.5	ton=45ns, toff=95nstyp	ID=-3.5A, VDD=-50V			164	GDS	2SJ134
1600	65	0	-10					0.6	-10	-3.5	ton=45ns, toff=95nstyp	ID=-3.5A, VDD=-50V			274	GDS	2SJ135
1500	80	0	-10					0.3	-10	-6.5	ton=70ns, toff=165nstyp	ID=-6.5A, VDD=-30V			164	GDS	2SJ136
1500	80	0	-10					0.3	-10	-6.5	ton=70ns, toff=165nstyp	ID=-6.5A, VDD=-30V			274	GDS	2SJ137